# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-118440

(43) Date of publication of application: 27.04.2001

(51)Int.Cl.

H01B 13/00

H05B 33/10

H05B 33/28

// C23C 14/02

(21)Application number : **11-295404** 

(71)Applicant: TOYOTA MOTOR CORP

(22)Date of filing:

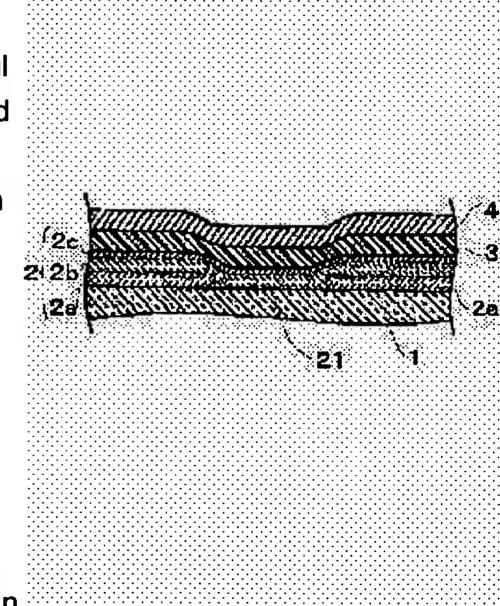
18.10.1999

(72)Inventor: ONO HIROTAKA

# (54) FORMING METHOD FOR TRANSPARENT CONDUCTIVE FILM

# (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a forming method for a transparent conductive film, which is useful as a transparent electrode of an organic EL element and the like, and have no foreign substances and pin holes. SOLUTION: Plurality of thin films are deposited on each other to form a transparent conductive film. First, the transparent conductive film made from glass, acrylic resin and the like is washed by processes, such as washing with pure water, ultrasonic washing with acetone, etc., and dried by blowing of nitrogen gas. A first thin film is grown on the surface of the resulting conductive film by vacuum deposition. The first thin film is washed and dried as described above, and a second thin film is grown on the first thin film. In this way, the thin



films are deposited in sequence to form a transparent conductive film having a desired thickness. Although pin holes occur on the respective thin films, they are swept off as the next thin film is filled. Also, although pin holes occur the outer thin film, they are out of question by virtue of the presence of the underlying thin film.

## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

## (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2001-118440 (P2001-118440A)

(43)公開日 平成13年4月27日(2001.4.27)

(51) Int.CL'		識別記号	ΡI		デーマコート*(参考)		
H01B	13/00	503	H01B	13/00	503B	3 K O O 7	
H05B	33/10		H05B	33/10		4K029	
	33/28			33/28		5 G 3 2 3	
// C23C	14/02		C 2 3 C	14/02	Z		

審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全 4 頁)

(21) 出願番号 特顯平11-295404

(22)出顧日 平成11年10月18日(1999.10.18)

(71)出願人 000003207

卜马夕自動車株式会社

愛知県豊田市トヨタ町1番地

(72)発明者 大野 裕孝

愛知県豊田市トヨタ町1番地 トヨタ自動

車株式会社内

Fターム(参考) 3K007 AB00 AB05 AB13 AB18 BB01

CA01 CB01 DA00 DA02 DB03

EBOO FA01 FA02

4K029 BA50 BA62 BB02 BC09 GA00

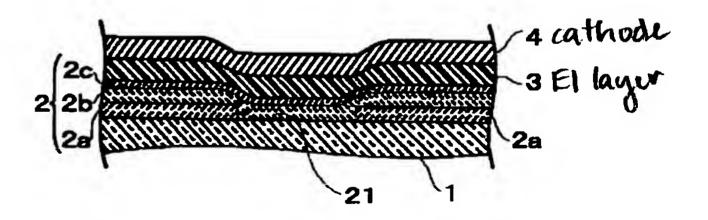
5G323 BA01 BA02 BB04

## (54) 【発明の名称】 透明導電膜の形成方法

## (57)【要約】

【課題】 有機EL素子等の透明電極として有用であり、異物及びピンホールを有さない透明導電膜の形成方法を提供する。

【解決手段】 透明薄電膜を複数の薄膜を積層させることにより形成する。先ず、ガラス、アクリル樹脂等からなる透明基板の表面を純水による洗浄、アセトン等を用いた超音波洗浄等の方法により洗浄した後、窒素等を吹き付けて乾燥させ、真空蒸着法等により1層目の薄膜を成膜する。次いで、この薄膜の表面を同様にして洗浄し、乾燥させ、その表面に2層目の薄膜を成膜する。このようにして薄膜を順次積層させ、所定厚さの透明導電膜を形成する。各々の薄膜にピンホールが生じたとしても、このピンホールは次の薄膜が充填されることにより消滅する。また、表層の薄膜にピンホールが生じたとしても、このピンホールは下層の薄膜があるため問題にはならない。



1

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板の表面に複数の薄膜からなる透明導 電膜を形成する方法において、洗浄工程と成膜工程とを 順次繰り返すことにより形成される上記薄膜を積層させ ることを特徴とする透明導電膜の形成方法。

【請求項2】 上記薄膜を2層又は3層積層させる請求 項1記載の透明導電膜の形成方法。

## 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、成膜時に取り込ま 10 れる異物が除去されて発生するピンホールが、複数の薄膜のうちの他の層により充填され、その結果、異物もピンホールも含まれず、導電膜としての性能低下のない透明導電膜の形成方法に関する。

#### [0002]

【従来の技術】真空蒸着などの方法によりガラス基板等の表面に金属酸化物などからなる透明導電膜を形成する場合、従来、所定厚さの導電膜が一回の操作で形成されている。このような透明導電膜を電極として有する製品に有機EL(エレクトロルミネッセンス)素子があり、この素子においてはガラス基板等の表面に形成される透明導電膜は、通常、陽極とされ、その表面に形成される有機EL膜を介して陰極が設けられる。この有機EL膜は非常に薄いものであり、特に、陽極に塵等の異物が含まれていたり、基板上に突状物があったりした場合は、その部位において更に薄くなって両極が短絡し、素子全体が発光しなくなることがある。

【0003】また、何らかの理由で異物が脱落すると、 異物が付着していた部分は異物で遮られてしまうため に、導電膜が成膜されていないピンホールとなる。この 30 ようなピンホールが発生した場合は、その部分が発光し ない等の問題が生ずる。更に、ピンホールの周縁の段差 によって、有機EL膜が局所的に薄くなって絶縁破壊を 生ずることもあり、両極が短絡して素子全体が発光しな くなることがある。また、絶縁破壊には至らないまで も、ピンホールの周縁に沿って有機EL膜にクラックを 生じ、ここから雰囲気の水分等が侵入し、有機EL膜が 部分的に破壊され、所謂、ダークスポットを生ずること もある。

【0004】特開平11-121172号公報では、有 40 機EL素子における電流リークに大きく関与しているのは基板上の微細な塵であるとされている。そして、粒子の直進性が高い蒸着法により有機層を形成した場合、塵の裏側には粒子が付着せず、その後、粒子が回り込み易いスパッタ法により電子注入電極を設けた場合、この電極が塵の裏側にも形成され、ホール注入電極と直接接触することになり電流リークを生ずると説明されている。そして、この電流リークを防止するため、有機層はスピンコート法又はディップ法により形成されている。しかし、同公報に記載の技術では、塵が脱落し、ピンホール 50

を生じた場合については何ら考慮されていない。また、 有機層をスピンコート法又はディップ法により形成する ため、すべての層を同一の真空処理槽において形成する 方法に比べて生産性に劣るとの問題もある。

#### [0005]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記の従来 技術の問題点を解決するものであり、成膜時に異物が取 り込まれたとしても洗浄により除去され、異物の除去に より発生するピンホールも他の薄膜を成膜する際に充填 され、異物もピンホールも含まれず、薄電膜としての性 能低下のない透明導電膜の形成方法を提供することを目 的とする。

#### [0006]

【課題を解決するための手段】第1発明の透明導電膜の 形成方法は、基板の表面に複数の薄膜からなる透明導電 膜を形成する方法であって、洗浄工程と製膜工程とを順 次繰り返すことにより形成される上記薄膜を積層させる ことを特徴とする。

【0007】第1発明では、基板を洗浄した後、その表面に第1層目の透明導電性薄膜を形成する。ここで、基板の表面に異物が残っていた場合、この異物は第1層目の薄膜に取り込まれる。次いで、この第1層目の薄膜の表面を洗浄する。この洗浄により第1層目の薄膜に取り込まれていた異物が脱落し、ピンホールが発生する。その後、第1層目の薄膜の表面に第2層目の透明導電性薄膜を形成する。この第2層目の薄膜が第1層目のピンホールに充填され、ピンホールは消滅する。このように洗浄と成膜とを順次繰り返して行うことにより、所要数の薄膜が積層され、異物及びピンホールを含まない所定厚さの透明導電膜を形成することができる。

【0008】基板及び各層の表面の洗浄は、アセトン、イソプロピルアルコール等の比較的沸点の低い有機溶剤を用いた超音波洗浄、及び純水による水洗等により行うことができ、これらを適宜組み合わせて洗浄することもできる。また、洗浄後、窒素等の不活性ガスを吹き付けること、或いは80~150℃の高温雰囲気に晒すこと等により乾燥させることが好ましい。薄膜の形成は、真空蒸着法、スピンコート法、キャスト法、スパッタリング法及びLB法等、各種の方法によって行うことができる。

【0009】積層される薄膜の層数は特に限定されないが、ピンホールの周縁における、段差、変形等を抑え、ピンホールの影響を最小限にするためには積層数を多くすることが好ましい。しかし、あまりに多層であると操作が煩雑となり、コストも上昇するため好ましくない。薄膜の層数は、2~5層、特に2~4層とすることができ、特に、第2発明のように、2層又は3層とすることが好ましい。薄膜が2層であっても1層目に発生したピンホールと2層目に発生したピンホールと2層目に発生したピンホールとなることはほ

cを形成した。

とんど有り得ず、異物及びピンホールを含まない透明導 電膜とすることができる。また、薄膜が3層であれば全 厚さを貫通するピンホールが発生しないとともに、透明 導電膜の全厚さが同程度である場合は各々の薄膜を更に 薄くすることができ、ピンホールが発生したとしても、 その周縁における段差、変形等は更に抑えられ、陽極と 陰極との短絡等が確実に防止される。

【0010】この透明導電膜は、各種の表示素子等にお いて電極として利用することができる。有機EL素子の 場合、透明導電膜はガラス製等の透明基板の表面に形成 され陽極となる。また、その表面には少なくとも発光層 を備える有機EL膜が形成される。透明導電膜の表層の 薄膜は下層に他の薄膜が存在するため、透明基板の表面 にまで至るピンホールが発生することはない。しかし、 その表面に形成される有機EL膜に及ぼす影響を最小限 にするため、表層の薄膜の厚さはできる限り薄くするこ とが好ましい。一方、この薄膜があまりに薄いと下層に 存在していたピンホールによる段差、変形等が有機EL 膜に影響を及ぼすことになる。そのため、これらを勘案 し、各々の薄膜を最適な厚さとすることが好ましい。更 20 における段差、変形は更に緩和される。 に、各薄膜、特に表層の薄膜の厚さを有機EL膜よりも 薄くすることによって、ピンホールの影響をより小さく することもできる。

【0011】2層の薄膜からなる透明薄電膜の場合は、 表層の厚さ(ts)の下層の厚さ(t1)に対する比(t s/t1)を0.5~1.0、特に0.6~0.9、更に は0.5~0.8程度とすることが好ましい。また、3 層の薄膜からなる透明薄電膜の場合は、中間層の厚さと 下層の厚さとを同程度とし、表層の厚さ(ts)の中間 の厚さ(ta)に対する比(ts/ta)を0.5~1. 0、特に0.6~0.9、更には0.5~0.8程度と することが好ましい。このように各々の薄膜の厚さの比 を特定することにより、存在していたピンホールによる 段差、変形等の影響が十分に緩和されるとともに、透明 導電膜の表面に形成される有機EL膜の品質が損なわれ ることもない。

#### [0012]

【発明の実施の形態】以下、有機EL素子の陽極を構成 する透明導電膜の形成に関する実施例により本発明を更 に詳しく説明する。

# 実施例1

この実施例では、3層の薄膜が積層されてなる透明導電 膜と、これを陽極とする有機EL素子を製造した。以 下、有機EL素子の断面を模式的に表す図1を用いて説 明する。

#### (1)透明導電膜の形成

のガラス製の透明基板1の表面を純水により洗浄した 後、窒素を吹き付けて乾燥させた。次いで、透明基板1 を真空処理槽に導入し、真空蒸着法により厚さ120 n mの透明導電膜としての第1薄膜2aを形成した。

②第1薄膜2aが形成された透明基板1を真空処理槽か ら取り出し、第1薄膜2aの表面を純水により洗浄した 後、窒素を吹き付けて乾燥させた。次いで、透明基板1 を再び真空処理槽に導入し、真空蒸着法により厚さ12 0 n mの透明導電膜としての第2薄膜2bを形成した。 3第1薄膜2a及び第2薄膜2bが形成された透明基板 1を真空処理槽から取り出し、第2薄膜2bの表面を純 水により洗浄した後、窒素を吹き付けて乾燥させた。次 いで、透明基板1を再び真空処理槽に導入し、真空蒸着 法により厚さ60mmの透明薄電膜としての第3薄膜2

【0013】このようにして3層の薄膜からなり全厚さ 300 nmの透明導電膜2を形成した。この透明導電膜 2において、第1薄膜aに異物が含まれていた場合、こ れが洗浄により取り除かれ、ピンホール21が発生す る。しかし、このピンホール21は第2薄膜2aの表面 に形成され、積層される第2薄膜2bにより充填され、 消滅する。また、この第2薄膜2bの表面に形成され、 積層される第3薄膜2cにより、ピンホール21の周縁

【0014】透明基板としては、有機EL膜の発光によ る文字、図形等の視認が損なわれない程度の透明性を有 する材質からなるものを使用することができる。また、 有機EL素子の表層としての形状を保持し得るだけの強 度を有し、且つ表面が容易に傷付かない程度の硬さを有 するものが好ましい。そのような基板としては、ガラス の他、ポリオレフィン、ポリエステル、ポリアミド、ポ リカーボネート、アクリル樹脂等からなるものを用いる ことができる。透明性の観点からはガラス及びポリカー 30 ボネート、ポリメチルメタクリレート等のアクリル樹脂 からなる基板が特に好ましい。この透明基板は無色透明 であってもよいし、適宜の色調に着色された着色透明の ものであってもよい。

【0015】陽極となる透明尊電膜は、金、ニッケル等 の金属単体、及びITO、CuI、SnO2、ZnO等 の金属化合物などを使用して形成することができ、生産 性、安定した導電性等の観点から I TOを用いて形成す ることが特に好ましい。

【0016】(2)有機EL素子の製造

(1)において形成した透明導電膜2をエッチング等に より所定形状にパターニングした後、この表面に常法に よって有機EL膜3及び陰極4を堆積した。その後、透 明導電膜2の、有機EL膜3及び陰極4が形成された面 の周縁に封止部材を封止樹脂により接合して有機EL素 子を製造した。

【0017】有機EL膜は少なくとも発光層を備え、こ の発光層の他、正孔輸送層及び/又は電子輸送層を備え ていてもよい。また、正孔注入層及び/又は電子注入層 を備えていてもよい。有機EL膜を構成する各層は、そ 50 れぞれ以下の種々の材質により形成することができる。

5

発光層は、ベンゾチアゾール系、ベンゾイミダゾール系 等の蛍光増白剤、及び金属キレート化オキシノイド化合 物、スチリルベンゼン系化合物等の金属錯体などにより 形成することができる。正孔輸送層はトリフェニルアミ ン誘導体等により、電子輸送層はアルミキノリウム錯体 等により形成することができる。また、正孔注入層は銅 フタロシアニン錯体等により、電子注入層はアルカリ金 属のフッ化物又は酸化物等により形成することができ る。

【0018】更に、陰極は、マグネシウム一銀合金又は 10 クスポットを生ずることもあり得る。 マグネシウムと銀との混合物、ナトリウム、ナトリウム ーカリウム合金、マグネシウム、リチウム、アルミニウ ム、A1/A1O2、或いはインジウム、イッテルビウ ム等によって形成することができる。

【0019】封止部材は、その周縁において透明基板と 接合される接合面を有し、その他の部分は、この封止部 材と有機EL膜或いは陰極とが接触しない程度の空間が 形成される形状であることが好ましい。その材質は特に 限定されず、ガラス、樹脂、金属等が使用される。

膜及び陰極が形成された面の周縁とは、封止樹脂によっ て接合される。この接合は、接合面に封止樹脂を塗布 し、必要に応じて乾燥させ、硬化させること等により行 うことができる。封止樹脂としては、エポキシ樹脂、ア クリレート樹脂等の熱硬化性樹脂の他、光硬化性樹脂な どを使用することができる。この光硬化性樹脂は、硬化 速度が大きいため特に好ましい。また、輝度の低下等を 抑えるため、水分等が透過し難い硬化体が形成される封 止樹脂を使用することがより好ましい。尚、水分等の侵 入を十分に抑えるためには、接合面における樹脂層の厚 30 さは薄いほうが有利であり、接合性が損なわれない範囲 でより薄くすることが好ましい。

## 【0021】比較例1

図2に示すように300 nmの厚さの透明導電膜2を1 回の成膜による単層の膜として形成した。この透明導電 膜2の表面に常法により有機EL膜と陰極とを堆積し、 封止部材を接合して有機EL素子を製造した。この有機 EL素子では、実施例1の場合と同様にして発生するピ

ンホール21は透明導電膜2の全厚さを貫通しており、 有機EL膜のピンホール21の周縁における段差、変形 は非常に大きい。また、この部分における有機EL膜の 厚さが薄くなる傾向にある。そのため、ピンホール21 の周縁において有機EL膜が絶縁破壊を生じ、透明導電 膜2と陰極4とが短絡し、有機EL素子の全面が発光し なくなることが推察される。また、ピンホール21の周 縁において有機EL膜3にクラックが発生し、分囲気の 水分が侵入して有機EL膜3が部分的に破壊され、ダー

【0022】尚、本発明においては、上記の実施例に限 られず、目的、用途に応じて本発明の範囲内で種々変更 した実施例とすることができる。即ち、透明導電膜は、 有機EL素子の他、液晶ディスプレイ、エレクトロケミ カルディスプレイ、電気泳動ディスプレイ及び分散粒子 配向型ディスプレイ等の各種の電子ディスプレイにおけ る透明電極として使用することができる。

#### [0023]

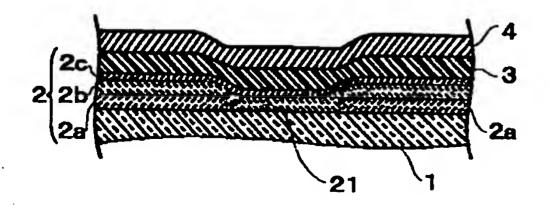
【発明の効果】第1発明によれば、複数の薄膜が積層さ 【0020】封止部材の接合面と、透明基板の有機EL 20 れてなる透明導電膜とすることにより、或る層にピンホ ールが発生しても他の層により充填され、消滅する。そ のため、この透明導電膜を陽極として有機EL素子等を 製造した場合に、陽極と陰極との短絡により素子の全面 が発光しなくなる等の問題を生ずることがない。また、 薄膜は、第2発明のように、2~3層とすることが好ま しく、これによりピンホールの発生による品質の低下を 十分に防止することができ、コストが大きく上昇するこ ともない。

# 【図面の簡単な説明】

【図1】実施例1における透明導電膜及びこれを陽極と する有機EL素子の断面の機略を表す模式図である。 【図2】 比較例1における透明導電膜及びこれを陽極と する有機EL素子の断面の概略を表す模式図である。 【符号の説明】

1;透明基板、2a、第1薄膜、2b;第2薄膜、2 c;第3薄膜、2;透明導電膜、3;有機EL膜、4; 陰極。

【図1】



【図2】

